

# 实验室半导体分立器件高精度选型测试设备

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 实验室半导体分立器件高精度选型测试设备                   |
| 公司名称 | 西安易恩电气科技有限公司                          |
| 价格   | .00/个                                 |
| 规格参数 | 品牌:西安易恩电气<br>产地:陕西西安<br>用途:半导体测试仪     |
| 公司地址 | 西安市高陵区融豪工业城(中小企业创业示范园<br>微型第10座5层01号) |
| 联系电话 | 029-86095858 15249202572              |

## 产品详情

西安易恩电气坐落于西安渭北工业装备区，是陕西省政府重点支持的高新技术企业。公司专注于研发、生产和销售半导体封装、测试设备。现已成为国内电力电子行业的测试方案供应商。公司以自主研发生产的“轨道机车半导体测试系统”系列产品为主导，在此基础上相继推出全自动大功率IGBT参数测试系统，分立器件综合测试仪，功率器件图示系统，晶体管图示仪，MOS动静态测试测试仪，晶闸管测试仪，雪崩、浪涌、高温阻断、高温反偏、栅电荷测试系统等系列产品。广泛应用于科研院所、能源、电力电子、交通、船舶制造、高校等诸多领域。

分立器件测试设备测试可测试市面上常见的18类分立器件静态全参数，如一下参数；

### 1、二极管DIODE

测试参数名称

电压范围

电流范围

分辨率

精度

IR

0.10V-2kV

1nA(20pA)1-50mA

1nA(1pA)1

1%+10nA+20pA/V

(1%+200pA+2pA/V)1

BVR

1nA-3A

1mV

1%+10mV

VF

0.10V-5.00V

-9.99V

IF:10uA-50A(1250A)3

-25A(750A)3

VF:1%+10mV

IF:1%+1nA

## 2、绝缘栅双极大功率晶体管IGBT

ICES

IGESF

IGESR

0.10V-20V(80V)2

1nA(20pA)1-3A

BVCES

0.1V-900V

-1.4KV

-1.6KV

100 μ A-200mA

-100mA

-50mA

1%+100mV

VGETH

0.10V-20V(50V)2

VCE SAT ICON

VGEON VF

gFS(混合参数)

VCE:0.10V-5.00V

-9.99V

VGE:0.10V-9.99V

IC:10uA-50A(1250A)3

-25A(750A)3

IF, IGE:1nA-10A

V:1%+10mV

IF IC:1%+1nA

IGE:1%+5nA

### 3、晶体管 TRANSISTOR

ICBO ICEO/R/S/V

IEBO

1nA(20pA)1-50mA 1nA(20pA)1-3A

BVCEO

BVCBO

BVEBO

0.10V-900V

-1.4kV

-1.6kV

0.10V-2KV

1nA-200mA

-100mA

-50mA

hFE(1-10000)

VCE:0.10V-5.00V

-49.9V

-3A

IB:1nA-10A

0.01hFE

VCE: 1%+10mV

IC: 1%+1nA

IB: 1%+5nA

VCESAT VBESAT

VBE(VBEON) RE

VBE:0.10V-9.99V

IE:10uA-50A(1250A)3

V : 1% + 10mV

IE : 1% + 1nA

IB : 1% + 5nA

4、MOS场效应管 MOS-FET

IDSS/VIGSSFIGSSR

VGSFVGSR

BVDSS

1nA-50mA

VGSTH

0.10V-49.9V

ID:100uA-3A

1%+ 10mV

VDSON、VF(VSD)

IDON、VGSON

RDSON(混合参数)

gFS (混合参数)

VD VF:0.10V-5.00V

VGS:0.10V-9.99V

IFID:10uA-50A(1250A)3

IG:1nA-10A

IF.ID:1%+1nA

IG : 1%+5nA

## 5、J型场效应管J-FET

IGSS IDOFF

IDGO

VGS:0.10V-20V(80V)2

VDS:0.10V-999V

1nA(20pA)1-3A 1nA(20pA)1-50mA

BVDGO

BVGSS

VDSON , VGSON

IDSS , IDSON

RDSON (混合参数)

gFS (混合参数)

0.10V-5.00V

-9.99V

ID:10uA-50A(1250A)3

-25A(750A)3

ID:1%+1nA

IG:1%+5nA

VGSOFF

ID:1nA(20pA)2-3A

VD:0.10V-50V

1% + 10mV

## 6、单向可控硅整流器（普通晶闸管）SCR

IDRM、 IRRM、

IGKO

VDRM、 VRRM

BVGKO

VTM

10uA-50A(1250A)3

1 mV

VT:1%+10mV

IT:1%+1nA

I GT

VGT

VD:5V-49.9V

VGT:0.10V-20V(80V)2

VT:100mV-49.9V

IGT:1nA-3A

RL:12 /30 /100

/EXT

1nA

1%+5nA

IL(间接参数)

IL:100  $\mu$  A-3A

N/A

IH

IH:10 $\mu$ A-1.5A

(IAK初值由RL设置)

1 $\mu$ A

1%+2 $\mu$ A